

DS90CP04

DS90CP04 1.5 Gbps 4x4 LVDS Crosspoint Switch



Literature Number: JAJ984

DS90CP04

1.5Gbps、4 × 4 LVDS クロスポイント・スイッチ

概要

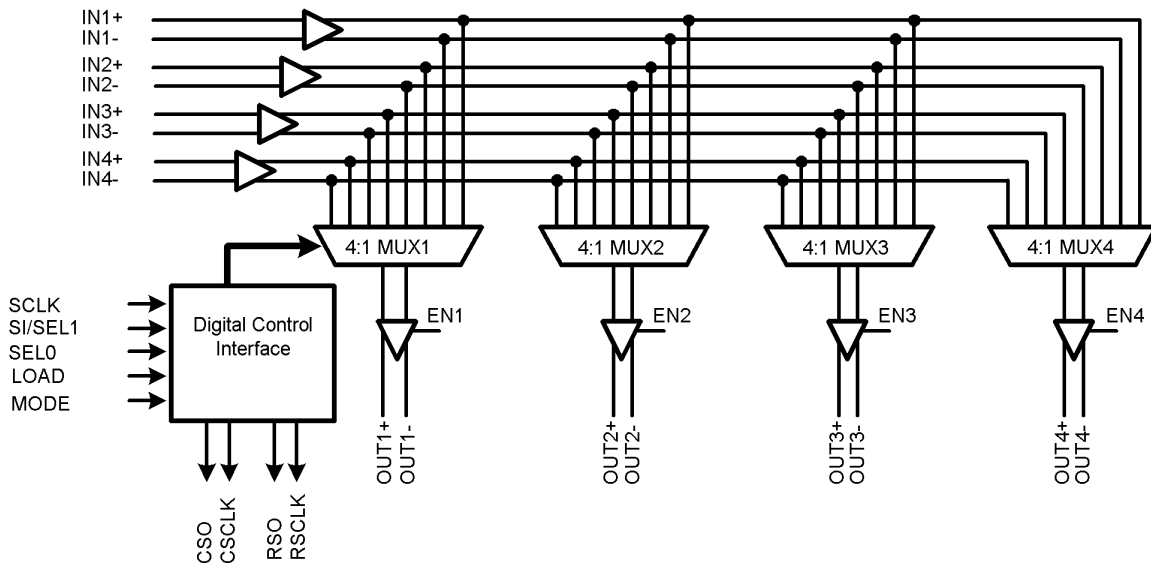
DS90CP04 は 4 × 4 のデジタル・クロスポイント・スイッチです。効率よく基板レイアウトが行えるように入力ピンと出力ピンをパッケージの対向両辺に配置しています。低電圧差動信号 (LVDS) 技術を採用し、低消費電力と高速動作の両立を実現しています。データ・パスは、ノイズを抑えるために入力から出力まですべて差動回路で構成されています。ノン・ブロッキング・アーキテクチャ方式により、任意の入力ビットから任意の出力ビット (単出力または複数の出力) への接続が可能です。スイッチ・マトリクスとして 4 組の差動 4:1 マルチプレクサを内蔵しています。各マルチプレクサには 4 入力系統がすべて接続されており、任意の出力チャネルから任意の 1 入力系統を出力できます。

MODE ピンによって、制御が容易なシリアル制御インタフェース、または構成選択ポートを切り替えられます。シリアル制御インタフェースを用いると、全出力に対する新規のスイッチ構成情報を単一のロード・コマンドによって一度に更新できます。

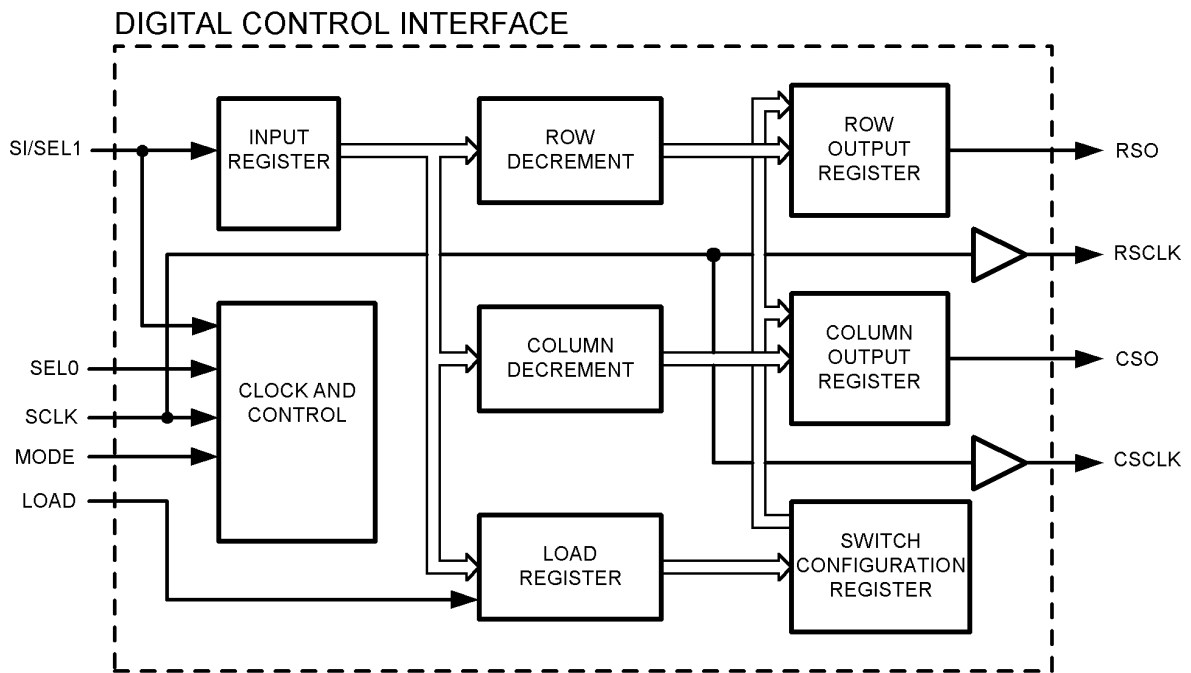
特長

- DC 1.5Gbps の低ジッタ、低スキュー動作
- ピンおよびシリアル・インタフェース採用、差動回路、ノン・ブロッキング・アーキテクチャ
- 入力共通モードの電圧範囲が広いため、LVDS、LVPECL、2.5V-CML ドライバとの容易なイネーブル・インタフェース
- TRI-STATE LVDS 出力
- 読み出し可能なシリアル制御インタフェース
- 2 段階のレジスタ書き込み
- + 2.5V 単一電源
- 6 × 6mm LLP-32 省スペース・パッケージ
- アドバンスト CMOS プロセス技術で製造

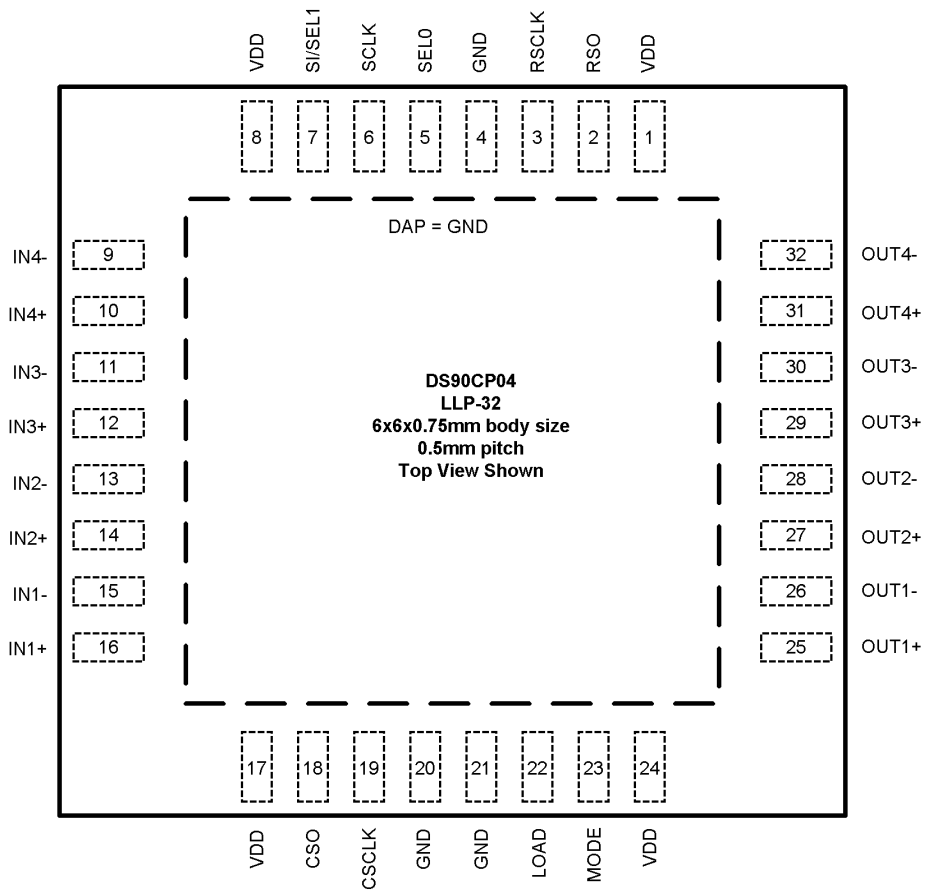
機能ブロック図



機能ブロック図(つぎ)



ピン配置図



Order Number DS90CP04TLQ, DS90CP04TLQX (Tape and Reel)
See NS Package Number LQA32A

ピン説明

ピン名	ピン番号	入出力、タイプ	説明
各マルチプレクサに共通の差動入力			
IN1 + IN1 -	16 15	I, LVDS	反転および非反転差動入力
IN2 + IN2 -	14 13	I, LVDS	反転および非反転差動入力
IN3 + IN3 -	12 11	I, LVDS	反転および非反転差動入力
IN4 + IN4 -	10 9	I, LVDS	反転および非反転差動入力
差動スイッチ出力			
OUT1 + OUT1 -	25 26	O, LVDS	反転および非反転差動出力。IN1 ±、IN2 ±、IN3 ±、IN4 ±の任意の差動ペアをOUT1 ±から出力可能
OUT2 + OUT2 -	27 28	O, LVDS	反転および非反転差動出力。IN1 ±、IN2 ±、IN3 ±、IN4 ±の任意の差動ペアをOUT2 ±から出力可能
OUT3 + OUT3 -	29 30	O, LVDS	反転および非反転差動出力。IN1 ±、IN2 ±、IN3 ±、IN4 ±の任意の差動ペアをOUT3 ±から出力可能
OUT4 + OUT4 -	31 32	O, LVDS	反転および非反転差動出力。IN1 ±、IN2 ±、IN3 ±、IN4 ±の任意の差動ペアをOUT4 ±から出力可能
デジタル制御インタフェース			
SCLK	6	I, LVCMOS	SI から入力されるプログラミング・データをラッチする制御クロックです。SCLK は 0MHz から 100MHz に対応しています。デバイスにアクセスするときのみ、SCLK にクロック・パルス列を与えてください。プログラミング完了後は、高速差動データ・バスに対するノイズ混入を防ぐため、SCLK は論理 LOW に保持してください。
SI / SEL1	7	I, LVCMOS	スイッチ構成を指定するプログラミング・データ入力です。データは SCLK の立ち上がりクロックで内部バッファ・レジスタにラッチされます。
SEL0	5	I, LVCMOS	スイッチ構成を指定するプログラミング・データです。
CSO RSO	18 2	O, LVCMOS	MODE が LOW のとき、シリアル・チェーンの次段のデバイスに向けて、コントロール・データが CSO (RSO) からシフト出力されます。CSO (RSO) から出力されるコントロール・データは SI に入力されたデータと同じですが、デバイスのコラム (ロー)・アドレスは内部で 1 ずつ減算されて、チェーンの次段のデバイスに伝達されます。CSO (RSO) は SCLK の立ち上がりエッジに同期して出力されます。
CSCLK RSCLK	19 3	O, LVCMOS	MODE が LOW のとき、これらのピンからは制御クロック SCLK をバッファしたクロック信号が出力されます。カスケード接続したシリアル制御バスで、CSCLK (RSCLK) はシリアル・チェーンの次段のデバイスに対するクロックとして使用します。
LOAD	22	I, LVCMOS	LOAD 信号が HIGH のとき SCLK を LOW から HIGH に遷移させると、デバイスはロード・レジスタに書き込まれているプログラミング・データを構成レジスタに転送します。このタイミングで全出力ピンは新規のスイッチ構成に切り替わります。LOAD 信号は 1 SCLK サイクルのみ HIGH にしてください。LOAD 信号を HIGH のまま保持すると構成レジスタへの転送が繰り返し発生します。
MODE	23	I, LVCMOS	MODE が LOW のとき SCLK 入力はアクティブとなり、バッファされた SCLK 信号が CSCLK/RSCLK ピンから出力されます。MODE が HIGH のとき、SCLK 信号はレジスタ回路と内部ステート・マシンから切り離されます。MODE が LOW になるまで内部レジスタ側から見た場合、負論理状態になっています。
POWER			
V _{DD}	1, 8, 17, 24	I, Power	V _{DD} は 2.5V ± 5% です。4 個以上の低 ESR 0.01 μF のバイパス・コンデンサを V _{DD} と GND 間に接続してください。
GND	4, 20, 21, DAP	I, Power	LVDS と CMOS 回路のグラウンド基準です。LLP-32 パッケージの下面には DAP があり金属コンタクトが露出しています。DAP はデバイスの主となるグラウンドになります。最適な AC および熱性能を得るため、4 個以上のビアでグラウンド層に接続してください。

シリアル・インタフェース真理値表

LOAD	MODE	SCLK	生じる動作
0	0	LH	SI ピンの現在のレベルが入力シフト・レジスタにクロック転送されます。
0	1	LH	SCLK 入力を内部レジスタおよび内部ステート・マシン入力から切り離します。MODE が再び LOW になるまで RSCLK と CSCLK には LOW が出力されます。下記の「構成選択真理値表」を参照してください。
LH	0	X	最後の有効フレームから OUT1 ~ OUT4 構成情報をロードします。ロード・レジスタの内容は構成レジスタに転送されます。スイッチ構成は SCLK 入力とは非同期に更新されず。
1	1	LH	SCLK 入力を内部レジスタおよび内部ステート・マシン入力から切り離します。MODE が再び LOW になるまで RSCLK と CSCLK には LOW が出力されます。下記の「構成選択真理値表」を参照してください。

構成選択真理値表

MODE	SEL1	SEL0	生じる動作
0	X	X	SEL0/1 ピンは構成選択モードでのみ機能します。以下を参照してください。
1	0	0	分配 : IN1 - OUT1 OUT2 OUT3 OUT4
1	0	1	分配 : IN2 - OUT1 OUT2 OUT3 OUT4
1	1	0	冗長 : IN1 - OUT1 OUT2、IN3 - OUT3 OUT4
1	1	1	対向接続 : IN1 - OUT1、IN2 - OUT2、IN3 - OUT3、IN4 - OUT4

LH: LOW から HIGH への遷移 (立ち上がりエッジ)

X: ドント・ケア

構成選択真理値表(つづき)

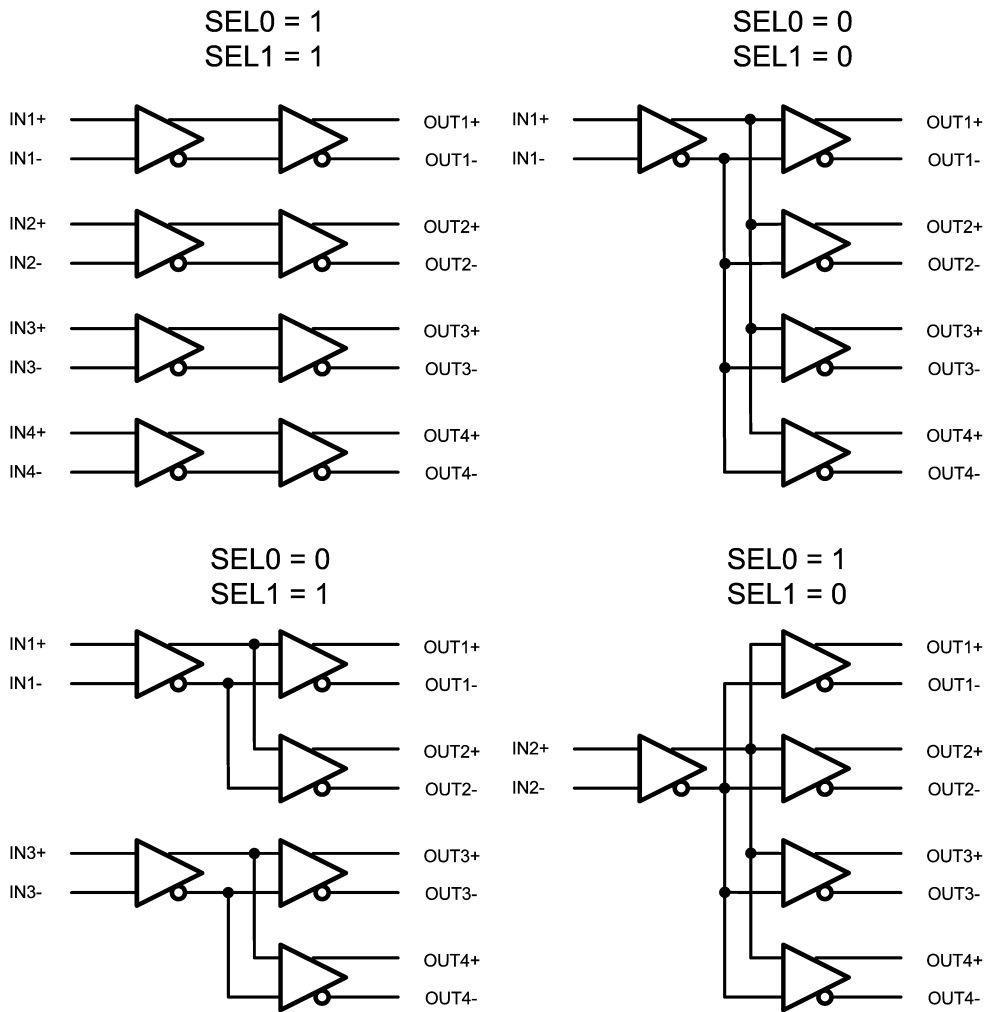


FIGURE 1. DS90CP04 Configuration Select Decode

絶対最大定格 (Note 1)

本データシートには軍用・航空宇宙用の規格は記載されていません。
関連する電気的信頼性試験方法の規格を参照ください。

電源電圧 (V_{DD})	- 0.3V ~ + 3V
CMOS/TTL 入力電圧	- 0.3V ~ ($V_{DD} + 0.3V$)
LVDS レシーバ入力電圧	- 0.3V ~ + 3.3V
LVDS ドライバ出力電圧	- 0.3V ~ + 3V
LVDS 出力短絡電流	40mA
最大接合部温度	+ 150
保存温度範囲	- 65 ~ + 150
リード温度 (ハンダ付け 4 秒)	+ 260
25 °C でのパッケージ最大消費電力	
LLP-32	3200 mW
デレーティング	25 °C 以上で 38mW/

熱抵抗 J_A	26.4	/W
ESD 耐圧		
人体モデル, 1.5k Ω 、100pF		
LVDS 出力	> 1.0kV	
LVDS 入力	> 1.5kV	
その他のピン	> 4.0kV	
EIAJ, 0 Ω 、200pF	> 100V	

推奨動作条件

	最小値	代表値	最大値	単位
電源電圧 ($V_{DD}-GND$)	2.375	2.5	2.625	V
レシーバ入力電圧	0.05		3.3	V
動作周囲温度	- 40	25	85	
接合部温度			110	

電気的特性

特記のない限り、推奨動作条件の電源電圧と動作周囲温度を対象

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ (Note 2)	Max	Units
LVCMS/LVTTL DC SPECIFICATIONS (SCLK, SI/SEL1, SEL0, LOAD, MODE, CSCLK, RSCLK, CSO, RSO)						
V_{IH}	High Level Input Voltage		1.7		V_{DD}	V
V_{IL}	Low Level Input Voltage		GND		0.7	V
I_{IH}	High Level Input Current	$V_{IN} = V_{DD} = V_{DDMAX}$	-10		+10	μA
I_{IL}	Low Level Input Current	$V_{IN} = V_{SS}, V_{DD} = V_{DDMAX}$	-10		+10	μA
C_{IN1}	Input Capacitance	Any Digital Input Pin to V_{SS}		3.5		pF
C_{OUT1}	Output Capacitance	Any Digital Output Pin to V_{SS}		5.5		pF
V_{CL}	Input Clamp Voltage	$I_{CL} = -18$ mA	-1.5	-0.8		V
V_{OH}	High Level Output Voltage	$I_{OH} = -4.0$ mA, $V_{DD} = V_{DDMIN}$	1.9			V
		$I_{OH} = -100$ μA , $V_{DD} = 2.5V$	2.4			V
V_{OL}	Low Level Output Voltage	$I_{OL} = 4.0$ mA, $V_{DD} = V_{DDMIN}$			0.4	V
		$I_{OL} = 100$ μA , $V_{DD} = 2.5V$			0.1	V
LVDS INPUT DC SPECIFICATIONS (IN1\pm, IN2\pm, IN3\pm, IN4\pm)						
V_{TH}	Differential Input High Threshold (Note 3)	$V_{CM} = 0.05V$ or 1.2V or 2.45V, $V_{DD} = 2.5V$		0	50	mV
V_{TL}	Differential Input Low Threshold	$V_{CM} = 0.05V$ or 1.2V or 2.45V, $V_{DD} = 2.5V$	-50	0		mV
V_{ID}	Differential Input Voltage	$V_{DD} = 2.5V$, $V_{CM} = 0.05V$ to 2.45V	100		V_{DD}	mV
V_{CMR}	Common Mode Voltage Range	$V_{ID} = 100$ mV, $V_{DD} = 2.5V$	0.05		3.25	V
C_{IN2}	Input Capacitance	IN+ or IN- to V_{SS}		3.5		pF
I_{IN}	Input Current	$V_{IN} = 2.5V$, $V_{DD} = V_{DDMAX}$ or 0V	-10		+10	μA
		$V_{IN} = 0V$, $V_{DD} = V_{DDMAX}$ or 0V	-10		+10	μA
LVDS OUTPUT DC SPECIFICATIONS (OUT1\pm, OUT2\pm, OUT3\pm, OUT4\pm)						
V_{OD}	Differential Output Voltage (Note 3)	$R_L = 100\Omega$ between OUT+ and OUT- Figure 2	250	400	475	mV
ΔV_{OD}	Change in V_{OD} between Complementary States		-35		35	mV
V_{OS}	Offset Voltage (Note 4)		1.125	1.25	1.375	V
ΔV_{OS}	Change in V_{OS} between Complementary States		-35		35	mV

電氣的特性 (つづき)

特記のない限り、推奨動作条件の電源電圧と動作周囲温度を対象

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ (Note 2)	Max	Units
I_{OZ}	Output TRI-STATE Current	TRI-STATE Output $V_{OUT} = V_{DD}$ or V_{SS}	-10		+10	μA
I_{OFF}	Power Off Leakage Current	$V_{DD} = 0V$, $V_{OUT} = 2.5V$ or GND	-10		+10	μA
I_{OS}	Output Short Circuit Current, One Complementary Output	OUT+ or OUT- Short to GND		-15	-40	mA
		OUT+ or OUT- Short to V_{DD}		15	40	mA
I_{OSB}	Output Short Circuit Current, both Complementary Outputs	OUT+ and OUT- Short to GND		-15	-30	mA
		OUT+ and OUT- Short to V_{CM}		15	30	mA
C_{OUT2}	Output Capacitance	OUT+ or OUT- to GND when TRI-STATE		5.5		pF

SUPPLY CURRENT

I_{CCD}	Total Supply Current	All inputs and outputs enabled, terminated with differential load of 100 Ω between OUT+ and OUT-.		220	300	mA
I_{CCZ}	TRI-STATE Supply Current	TRI-STATE All Outputs		10	20	mA

SWITCHING CHARACTERISTICS — LVDS OUTPUTS (Figures 3, 5, 6)

t_{LHT}	Differential Low to High Transition Time	Use an alternating 1 and 0 pattern at 200 Mb/s, measure between 20% and 80% of V_{OD} .	100	135	160	ps
t_{HLT}	Differential High to Low Transition Time		100	135	160	ps
t_{PLHD}	Differential Low to High Propagation Delay	Use an alternating 1 and 0 pattern at 200 Mb/s, measure at 50% V_{OD} between input to output.	500	750	1200	ps
t_{PHLD}	Differential High to Low Propagation Delay		500	750	1200	ps
t_{SKD1}	Pulse Skew	$ t_{PLHD} - t_{PHLD} $		0	30	ps
t_{SKCC}	Output Channel to Channel Skew	Difference in propagation delay (t_{PLHD} or t_{PHLD}) among all output channels in Broadcast mode (any one input to all outputs).	0	50	100	ps
t_{JIT}	Jitter (Note 5)	Alternating 1 and 0 Pattern	750 MHz	1.6	2.5	psrms
			1.25 GHz	1.6	2.5	psrms
		K28.5 Pattern	1.5 Gb/s	10	40	psp-p
			2.5 Gb/s	27	60	psp-p
		PRBS 2 ²³ -1 Pattern	1.5 Gb/s	25	40	psp-p
			2.5 Gb/s	40	70	psp-p
t_{ON}	LVDS Output Enable Time	Time from LOAD = LH or SELx to OUT \pm change from TRI-STATE to active.	50	150	300	ns
t_{OFF}	LVDS Output Disable Time	Time from LOAD = LH or SELx to OUT \pm change from active to TRI-STATE.		3	5	ns
t_{sw}	LVDS Switching Time	Time from LOAD = LH to new switch configuration effective for OUT \pm .		50	150	ns

電気的特性 (つづき)

特記のない限り、推奨動作条件の電源電圧と動作周囲温度を対象

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ (Note 2)	Max	Units
t_{SEL}	SELx to OUT±	Configuration select to new data at OUT±.		50	150	ns
SWITCHING CHARACTERISTICS — Serial control Interface (Figures 4, 8, 9)						
F_{SCLK}	SCLK Clock Frequency		0		100	MHz
T_{DCCLK}	CSCLK Duty Cycle RSCLK Duty Cycle	Input SCLK Duty Cycle set at 50%	45		55	%
t_S	SI–SCLK or MODE–SCLK Setup Time	From SI or MODE Input Data to SCLK Rising Edge	1.5			ns
t_H	SCLK–SI or SCLK–MODE Hold Time	From SCLK Rising Edge to SI or MODE Input Data	1			ns
t_{DSO}	SCLK to RSO or CSO Delay	From SCLK to RSO or CSO	1.5		4	ns
t_{DSCLK}	SCLK to RSCLK or CSCLK Delay	From SCLK to RSCLK or CSCLK	4.0		8.5	ns
t_{DSDIF}	ISCLK to RSCLK or CSCLK–SCLK to RSO or CSOI	Propagation Delay Difference between t_{DSO} and t_{DSCLK}	1.5		4.5	ns
T_{RISE}	Logic Low to High Transition Time	20% to 80% at RSO, CSO, RSCLK, or CSCLK		1.5		ns
T_{FALL}	Logic High to Low Transition Time	80% to 20% at RSO, CSO, RSCLK, or CSCLK		1.5		ns

Note 1: 「絶対最大定格」とは、この値を超えるとデバイスの安全を保障できない制限値を意味します。デバイスがこの規格値で正常に動作することを意味しているわけではありません。

Note 2: 代表値は $V_{DD} = 2.5V$ 、 $T_A = 25$ で測定されています。代表値は参照を目的としており、製造時検査は行っていません。

Note 3: 差動出力電圧 V_{OD} は $|OUT+ - OUT-|$ として定義されています。差動入力 V_{ID} は $|IN+ - IN-|$ として定義されています。

Note 4: 出力オフセット電圧 V_{OS} は、LVDS シングル・エンド出力の論理 HIGH 電圧と論理 LOW 電圧の平均として定義されています。

Note 5: 任意の入力から任意の 1 つの差動 LVDS 出力に対する、規定のデータレートとデータパターンで動作しているときの仕様規定で、このとき残りの 3 チャンネルは試験対象チャンネルとは非同期の 1.25Gb/s の K28.5 パターンで動作させています。ジッタは、製造時に検査はなされませんが、サンプルにもとづく特性を通して保証されています。ランダム・ジッタは 1,000 回分のヒストグラムのピーク・ツー・ピークとして測定されます。なお K28.5 パターンは、ビット・ストリーム 0011111010 1100000101 の繰り返しです。確定的ジッタ (DJ パターン) は、サンプル回数 350 回のヒストグラムの平均として測定されています。総ジッタ (TJ) は、3,500 回分のヒストグラムで、ランダム・ジッタと同様にピーク・ツー・ピークとして測定されています。

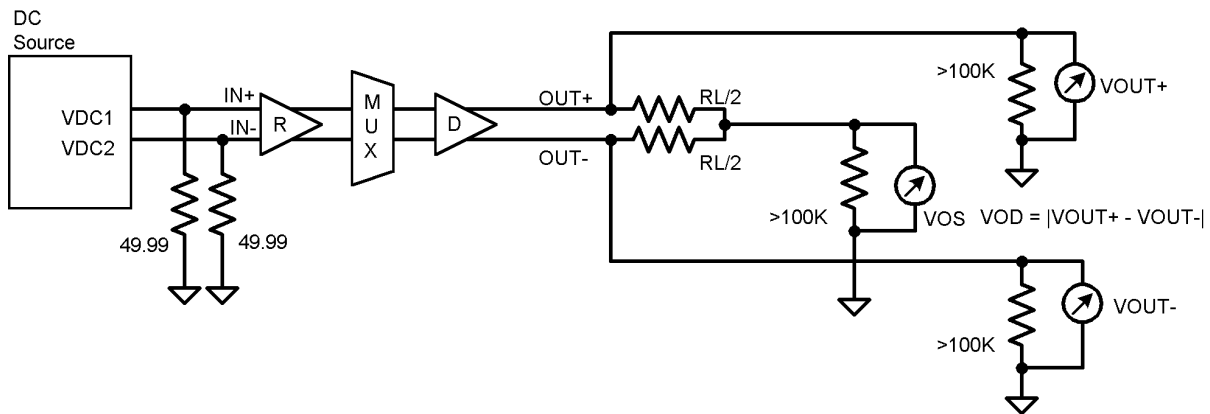


FIGURE 2. Differential Driver DC Test Circuit

電気的特性 (つづき)

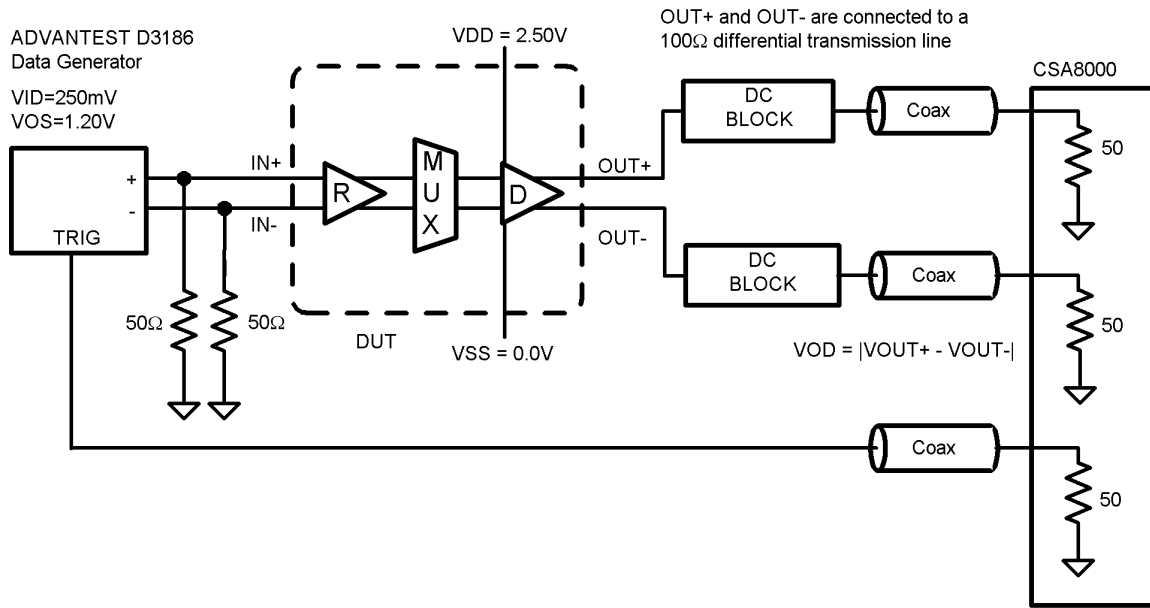


FIGURE 3. Differential Driver AC Test Circuit

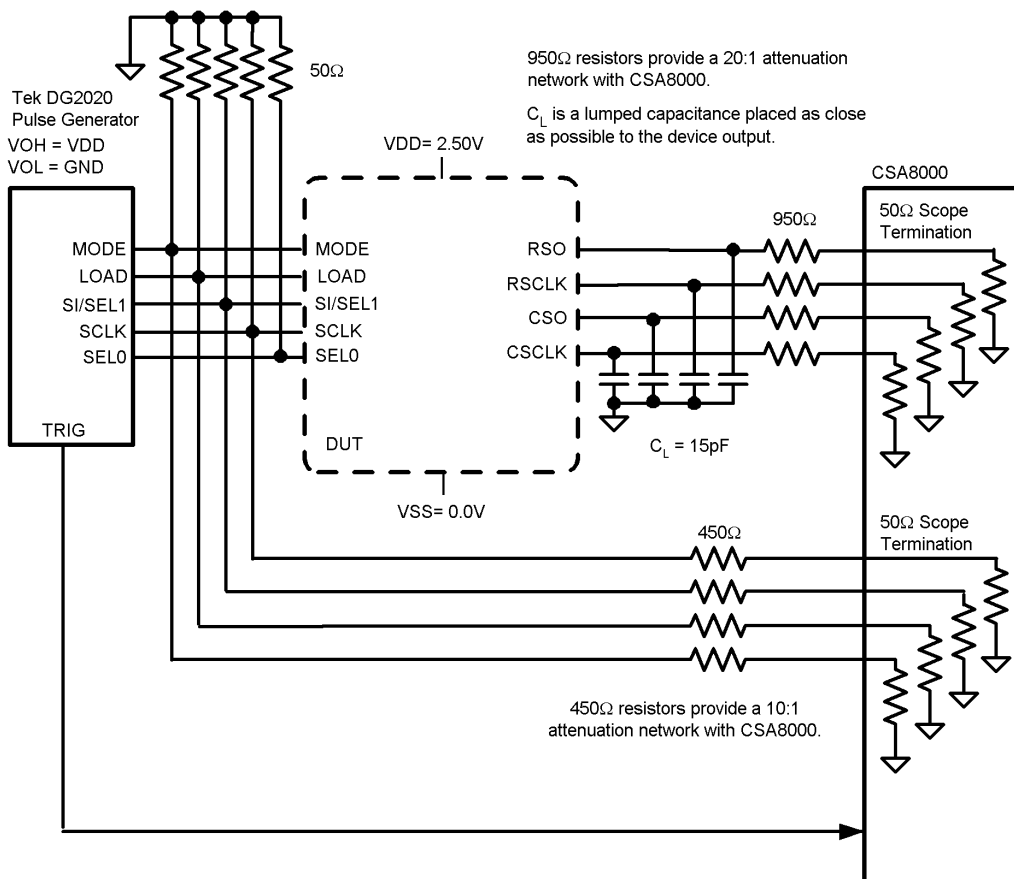


FIGURE 4. LVCMOS Driver AC Test Circuit (Note 6)

電気的特性(つづき)

Note 6: LVCMOS 入力と出力の AC 仕様は、Figure 4 に示される電力スプリッタではなく、入力減衰ネットワークを使用しても検証および検査が可能です。

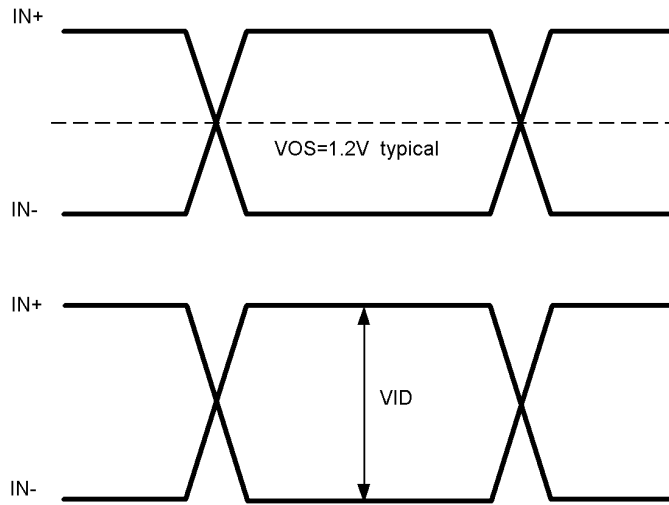


FIGURE 5. LVDS Signals

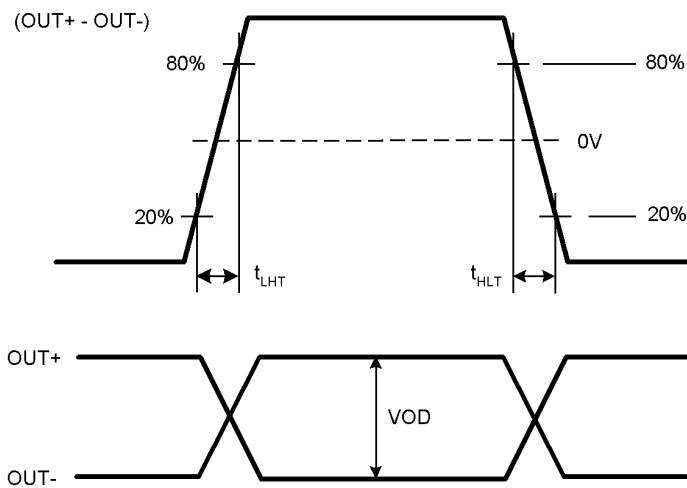


FIGURE 6. LVDS Output Transition Time

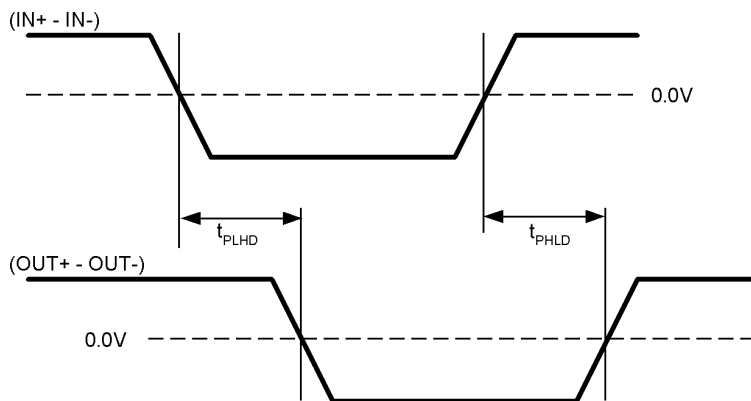


FIGURE 7. LVDS Output Propagation Delay

電気的特性 (つづき)

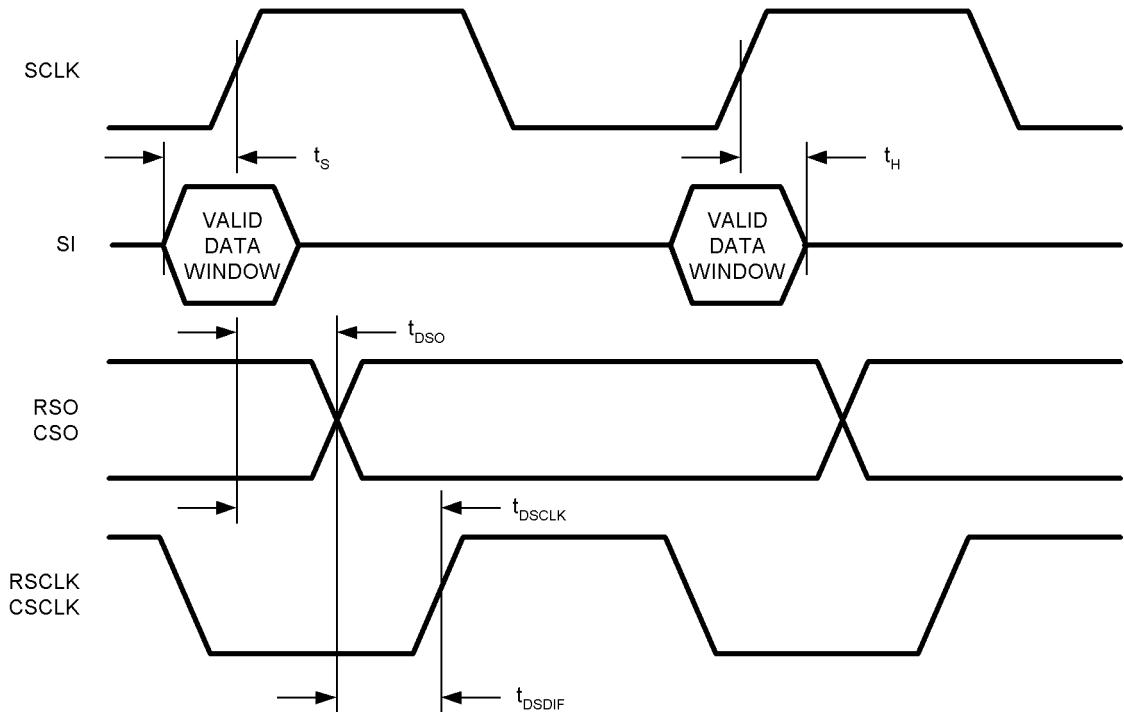


FIGURE 8. Serial Interface Propagation Delay and Input Timing Waveforms

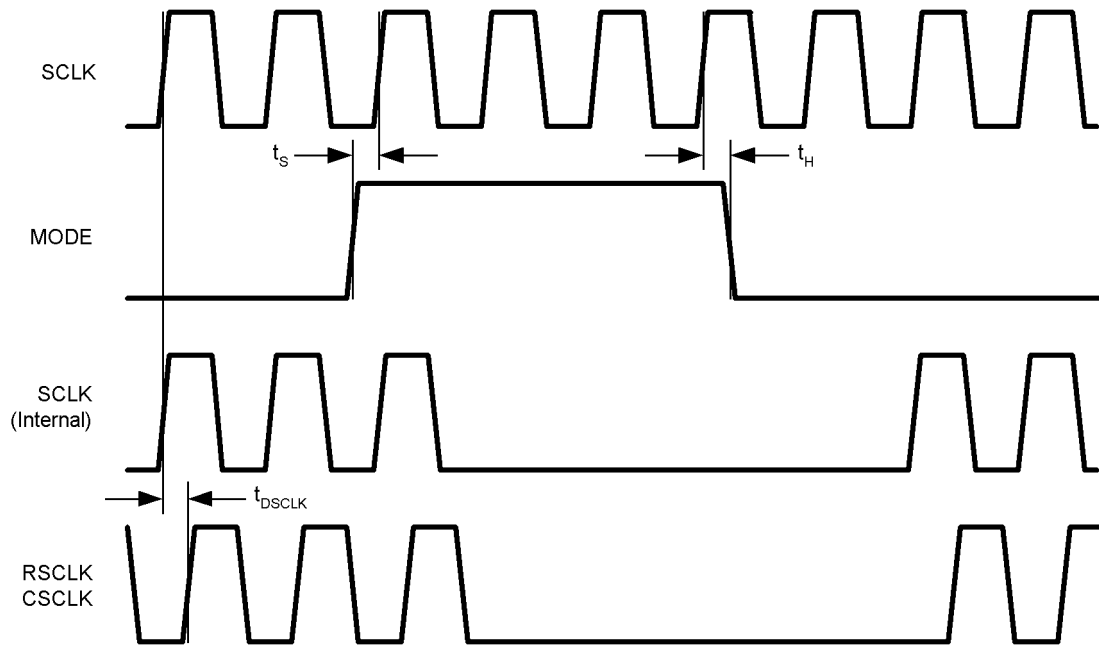


FIGURE 9. Serial Interface MODE Timing and Functionality

電気的特性 (つぎ)

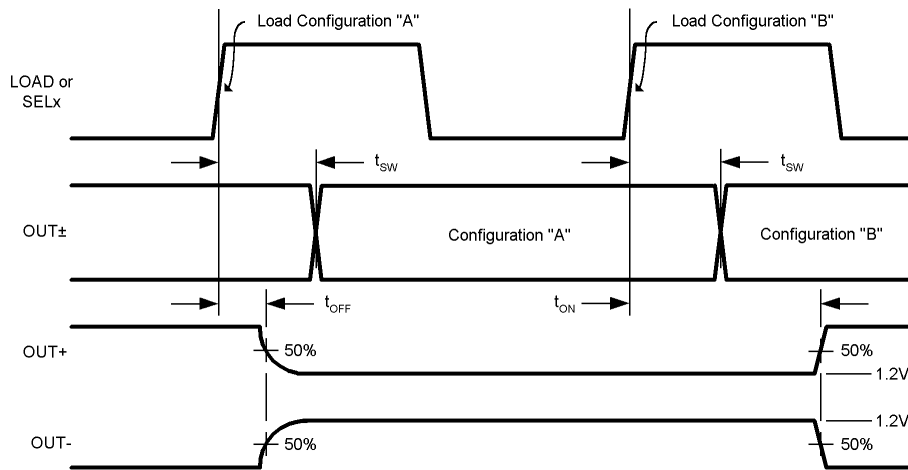


FIGURE 10. Configuration and Output Enable/Disable Timing

機能説明

シリアル・インタフェースによるプログラミング

シリアル・クロック SCLK とシリアル入力データライン SI で構成される単純なシリアル・インタフェースを介して、内部マルチプレクサに構成をプログラムできます。シリアル・インタフェースは、大規模スイッチ・アレイに容易に拡張できるように設計されています。DS90CP04 で構成したマトリクス・アレイの次段のロー・デバイスは、バッファされたシリアル・インタフェース出力 (RSCLK、RSO) を使って接続します。同様に、マトリクス・アレイの次段のコラム・デバイスは、バッファされたシリアル・インタフェース出力 (CSCLK、CSO) を使って接続します。このフィードスルーされる RSCLK と RSO、CSCLK と CSO の各バッファ信号を使用する方

式により、ユーザーは単一のバス (SCLK と SI) でマトリクス内のすべてのデバイスをプログラムできます。

スイッチの構成をプログラムするには、デバイスに 30 ビットの制御ワードを与えます。最初の 6 ビットでスタート・フレームが SI にシフトインされます。有効スタート・フレームには、構成ロードの 1FH と、構成読み出しの 1EH の 2 種類があります。スタート・フレームに続いて、アクセスするデバイスのロー・アドレスとコラム・アドレス、さらに 4 チャンネル分のスイッチ構成データが送られます。Table 1 および Table 2 に制御ワードのビット定義を示します。D29 が SI にシフトインされる先頭ビットです。

TABLE 1. 30-Bit Control Word

ビット	ビット長	説明
D29-D24	6	制御ワード同期用のスタート・フレームです。(01 1111'b = LOAD)
D23-D18	6	アクセスするデバイスのロー・アドレスを指定します。シリアル・インタフェースは最大 64 個のロー・デバイスをアクセスできます。
D17-D12	6	アクセスするデバイスのコラム・アドレスを指定します。シリアル・インタフェースは最大 64 個のコラム・デバイスをアクセスできます。
D11-D9	3	出力 1 用のスイッチ構成を指定します。Table 2 を参照してください。
D8-D6	3	出力 2 用のスイッチ構成を指定します。Table 2 を参照してください。
D5-D3	3	出力 3 用のスイッチ構成を指定します。Table 2 を参照してください。
D2-D0	3	出力 4 用のスイッチ構成を指定します。Table 2 を参照してください。

TABLE 2. Switch Configuration Data

MSB		LSB	OUT1 ± に対する接続	OUT2 ± に対する接続	OUT3 ± に対する接続	OUT4 ± に対する接続
0	0	0	出力 1 は TRI-STATE	出力 2 は TRI-STATE	出力 3 は TRI-STATE	出力 4 は TRI-STATE
0	0	1	IN1 ±	IN1 ±	IN1 ±	IN1 ±
0	1	0	IN2 ±	IN2 ±	IN2 ±	IN2 ±
0	1	1	IN3 ±	IN3 ±	IN3 ±	IN3 ±
1	0	0	IN4 ±	IN4 ±	IN4 ±	IN4 ±
1	0	1	無効。			

機能説明 (つづき)

TABLE 2. Switch Configuration Data (つづき)

MSB		LSB	OUT1 ± に対する接続	OUT2 ± に対する接続	OUT3 ± に対する接続	OUT4 ± に対する接続
1	1	0	これらの無効の組み合わせは同期の喪失を招きます。			
1	1	1				

ローおよびコラム・アドレスシグ

デバイスを $N \times N$ アレイで構成した場合、左上のデバイスがロー・アドレス、コラム・アドレスともゼロに割り当てられます。右側に続くデバイスがコラム・アドレス 1 から N 、対して下側に続くデバイスがロー・アドレス 1 から N となります。システムのシリアル制御インタフェース (SCLK と SI) は、ロー・アドレス、コラム・アドレスともゼロのデバイスに接続します。シリアル制御インタフェースから、アクセスしたいデバイスのロー・アドレスとコラム・アドレスを含む制御ワードがシフト・インされます。制御データがデバイスに与えられると、次のローおよびコラム・デバイスに送られる前に、制御ワード内のアドレスは内部で 1 だけ減算されます。ロー・アドレスが 1 だけ減算された制御データがコラム・インタフェース (CSO と CSCLK) から送出され、コラム・アドレスが 1 だけ減算された制御データがロー・インタフェース (RSO と RSCLK) からシフト・アウトされます。プログラミングの対象となるデバイスに制御ワードが到達した時点では、ロー・アドレスとコラム・アドレスはともにもゼロとなっています。

アレイ内の各デバイスは、常に開始フレームの受信をチェックしています (D29 ~ 24 = 01 1111'b または 01 1110'b)。適正な開始フレーム・ストリングを検出し、かつ続くロー・アドレスとコラム・アドレスがともにもゼロであった場合、そのデバイスは 30 ビット制御ワードのスイッチ構成データをロード・レジスタに格納します。

アレイ内の各デバイスは、シリアル・インタフェースを介して順にプログラムされます。アレイ全体のプログラミングが完了したら、LOAD ピンに HIGH パルスを与えて、各デバイスのロード・レジスタの内容を構成レジスタに転送します。LOAD パルスの発行は、制御ワードの最終ビットがロード・レジスタに格納されるまで待たなければなりません。このタイミングが保証されるのはプログラムが完了した 2 クロック後です。

アレイのプログラムでは、内部シフト・レジスタで生じる追加の SCLK サイクルを考慮しなければなりません。次段に与える制御データが RSO と CSO に現れるまでのレイテンシは、立ち上がりエッジ 7 クロック (SCLK) 分です。アレイ内の目的とするデバイスに制御ワードを届けるためには、設計者は正しいクロック数を与える必要があります。4 デバイスをシリアル・チェーン接続した場合の制御ワードの例を Table 3 に示します (OUT1 = IN1, OUT2 = IN2, OUT16

= IN16)。このアレイのプログラムには、シリアル・チェーンを介して目的とするデバイスに届けるために、4 組の 30 ビット制御ワードが必要です。アレイ全体を 120 クロック・サイクルでプログラミングするには、チェーンの最後にあるデバイスからプログラミングをしていくことが重要です。続くプログラミング・データによって、最初のデータはチェーンを通して正しいデバイスに向かって押し込まれていきます。

スイッチ構成の読み出し

DS90CP04 に読み出し用の開始フレーム (01 1110'b) を送ると読み出しモードになります。読み出し開始フレームを受信すると構成レジスタ情報はシフト・レジスタに転送され、制御ワードの OUT1 ~ OUT4 のビット・セグメントの読み出し値が RSO と CSO の両方から出力されます。デバイスから読み出されたデータは、デフォルト・アドレス (11 1111'b) が 1 ずつ内部で減算されながら次段のデバイスを順に通って送られます。ロー最後尾にあるデバイスの RSO には、読み出しデバイスを始点とする「相対的」なコラム・アドレスが現れるため、送出デバイスのコラム位置を求められます。同様に、コラム最後尾にあるデバイスの CSO には、送出デバイスの相対ロー・アドレスが現れます。チャンネル構成情報が挿入された読み出し制御ワードの送出後、デバイスは自動的に書き込みモードに戻り、SI から入力される新規の制御ワードを待ちます。

Table 4 に、 4×4 デバイス・アレイの先頭のローにある 4 個のデバイスから構成レジスタを読み出す例を示します。すでに述べたように、アレイ読み出しの完了にも、内部シフト・レジスタのレイテンシ分を充当するだけの追加 SCLK サイクルが必要です。4 組分の 30 ビットの構成レジスタをシフト・アウトするには、 4×30 SCLK クロック・サイクルに加え、デバイス・レイテンシ分としてデバイス 1 個あたり 7 SCLK サイクルが必要で、合計 SCLK 数は 148 になります。シリアル化された読み出しデータは、ロー最後尾のデバイス RSO から RSCLK に同期して出力されます。4 組分の構成データの読み出しをシフト・インしたあとは、SI を LOW にしておくことを推奨します。

TABLE 3. Example to Program a 4 Device Array

フレーム D29:D24	ロー・ アドレス D23:D18	コラム・ アドレス D17:D12	OUT1 D11:D9	OUT2 D8:D6	OUT3 D5:D3	OUT4 D2:D0	SCLK サイクル数	制御ワードのア レイ内アクセス 先デバイス ロー、コラム
01 1111	00 0000	00 0011	001	010	011	100	30	0, 3
01 1111	00 0000	00 0010	001	010	011	100	30	0, 2
01 1111	00 0000	00 0001	001	010	011	100	30	0, 1
01 1111	00 0000	00 0000	001	010	011	100	30	0, 0
プログラミング工程のアレイ・レイテンシを最小にするため、システムの SI 入力から最も遠いデバイスの構成情報からシフト・インしてください。								
すべてのチャンネル情報がロード・レジスタに到達してからすべてのスイッチが構成可能になるまでに 2 クロック・サイクルの遅延が必要です。								2

機能説明 (つづき)

TABLE 4. A Read-Back Example from a 4 Device Array

フレーム D29:D24	ロー・ アドレス D23:D18	コラム・ アドレス D17:D12	OUT1 D11:D9	OUT2 D8:D6	OUT3 D5:D3	OUT4 D2:D0	SCLK サイクル数	説明
01 1110	00 0000	11 1111	000	000	000	000	30	Read-Back (R,C) = 0, 3
01 1110	00 0000	11 1110	000	000	000	000	30	Read-Back (R,C) = 0, 2
01 1110	00 0000	11 1101	000	000	000	000	30	Read-Back (R,C) = 0, 1
01 1110	00 0000	11 1100	001	010	011	100	30	Read-Back (R,C) = 0, 0

Note 7: 書き込みと読み出しのプログラミング例は、Figure 11 に示される 16 × 16 アレイ構成に基づいています。別のアレイ構成ではプログラミング順は異なります。

最小プログラミング・レイテンシとなるスイッチ拡張
プログラミング・データは、ロー方向は RSO と RSCLK を通って、
コラム方向は CSO と CSCLK を通って伝えられます。すべてのデ
バイスの LOAD ピンは電氣的に共通に接続し、同一信号で駆動

します。LOAD の信号品質に影響を与えないよう、アレイ内のス
タブ長が極端に長くないように配線してください。大規模クロ
スポイント・アプリケーションの場合、LOAD 信号は各ローまたは
各コラムごとに分配することを推奨します。

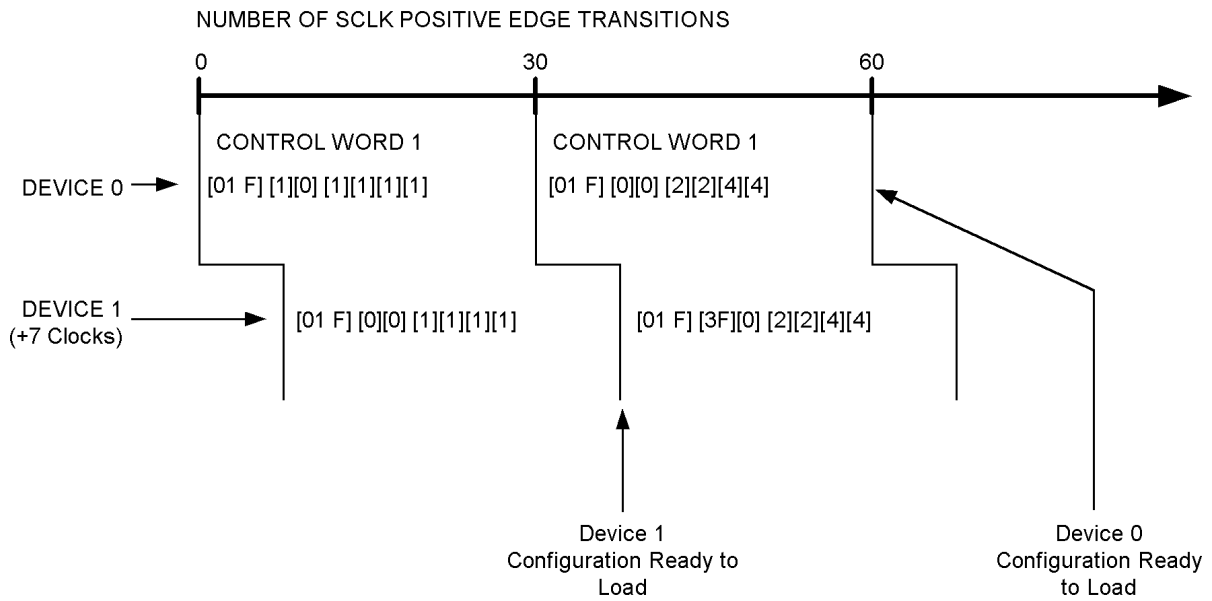


FIGURE 11.

プログラミングの例

構成書き込み

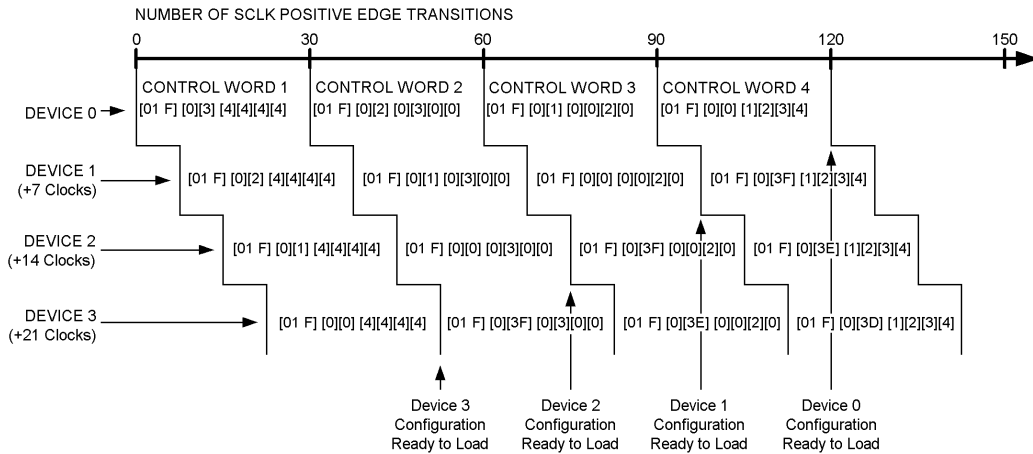
30ビット制御ワード: [書き込みフレーム][ロー・アドレス][コラム・アドレス][OUT1][OUT2][OUT3][OUT4]

アレイ書き込み

[01 1111] [0][1] [1][1][1][1] // *アレイ位置 1、ブロードキャスト IN1 *//

[01 1111] [0][0] [2][2][4][4] // *アレイ位置 0、IN2をOUT1とOUT2に接続、IN4をOUT3とOUT4に接続 *//

LOAD = H, SCLK = LH



デバイス 0 書き込みプログラミング・シーケンス

SCLK 数	イベントの説明
6	デバイス 0 (R = 0, C = 0) は第 1 の制御ワードの「書き込み」フレームを検出します。
18	デバイス 0 (R = 0, C = 0) は第 1 制御ワードのアドレスがロー = 1, コラム = 0であることを識別します。第 1 の制御ワードからロー・アドレスが 1 だけ減算され (ロー・アドレス = 0) RSO に送られます。
36	デバイス 0 (R = 0, C = 0) は第 2 の制御ワードの「書き込み」フレームを検出します。
48	デバイス 0 (R = 0, C = 0) は第 2 の制御ワードがロー = 0, コラム = 0であることを識別します。これは有効な構成書き込みアドレスのため、デバイス 0 は構成情報の受信を待ちます。
60	デバイス 0 (R = 0, C = 0) は構成情報を受信し LOAD を待ちます。

デバイス 1 書き込みプログラミング・シーケンス

SCLK 数	イベントの説明
13	デバイス 1 (R = 1, C = 0) は第 1 の制御ワードの「書き込み」フレームを検出します。
25	デバイス 1 (R = 1, C = 0) は第 2 の制御ワードのアドレスがロー = 0, コラム = 0であることを識別します。これは有効な構成書き込みアドレスのため、デバイス 1 は構成情報の受信を待ちます。
37	デバイス 1 (R = 1, C = 0) は構成情報を受信し LOAD を待ちます。
43	デバイス 1 (R = 1, C = 0) は第 2 の制御ワードの「書き込み」フレームを検出します。
55	デバイス 1 (R = 1, C = 0) は第 2 の制御ワードのアドレスがロー = 3F, コラム = 0であることを識別します。第 2 の制御ワードからロー・アドレスが 1 だけ減算され (ロー・アドレス = 3E) RSO に送られます。

構成読み出し

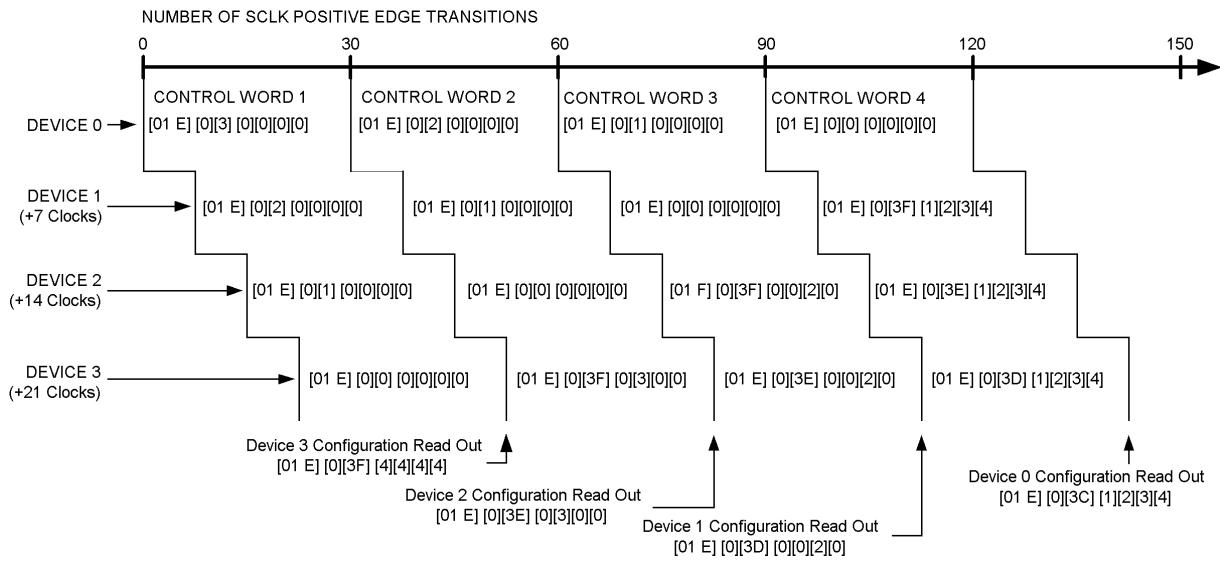
30ビット制御ワード: [読み出しフレーム][ロー・アドレス][コラム・アドレス][OUT1][OUT2][OUT3][OUT4]

アレイ書き込み

[01 1110] [1][0] [0][0][0][0] // *アレイ位置 1、構成情報の読み出し *//

[01 1110] [0][0] [0][0][0][0] // *アレイ位置 0、構成情報の読み出し *//

プログラミングの例 (つぎ)



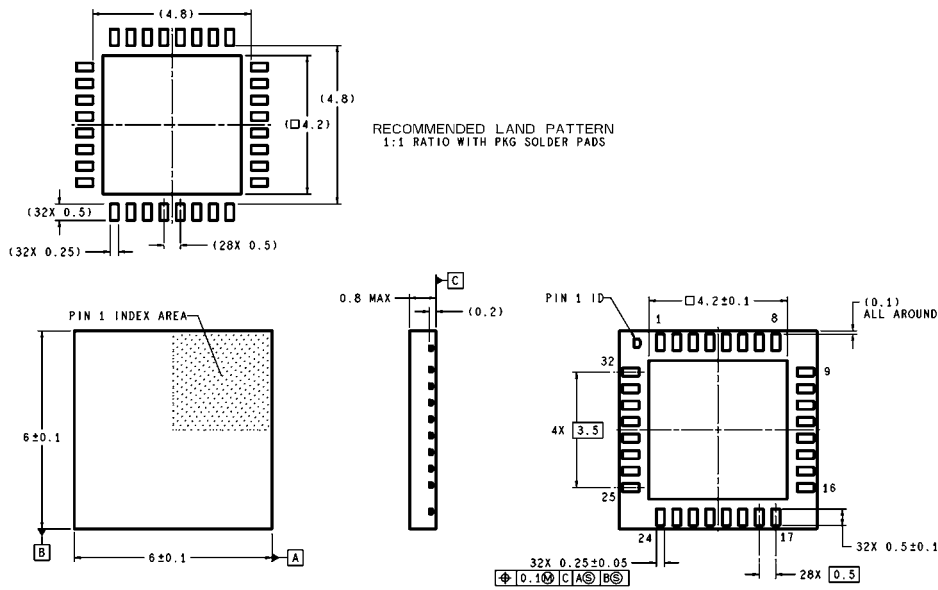
デバイス 0 読み出しプログラミング・シーケンス

SCLK 数	イベントの説明
6	デバイス 0 (R = 0, C = 0) は第 1 の制御ワードの「読み出し」フレームを検出します。
18	デバイス 0 (R = 0, C = 0) は第 1 制御ワードのアドレスがロー = 1、コラム = 0であることを識別します。第 1 の制御ワードからロー・アドレスが 1 だけ減算され (ロー・アドレス = 0) RSO に送られます。
36	デバイス 0 (R = 0, C = 0) は第 2 の制御ワードの「書き込み」フレームを検出します。
48	デバイス 0 (R = 0, C = 0) は第 2 の制御ワードがロー = 0、コラム = 0であることを識別します。これは有効な構成書き込みアドレスのため、デバイス 0 は構成情報の送信を準備します。最後の制御ワードからロー・アドレスが 1 だけ減算され (ロー・アドレス = 3F) RSO に送られます。
60	デバイス 0 (R = 0, C = 0) は構成情報を送信します。
74	アレイ出力 (デバイス 1 の RSO) から構成情報の送りが終わります。

デバイス 1 読み出しプログラミング・シーケンス

SCLK 数	イベントの説明
13	デバイス 1 (R = 1, C = 0) は第 1 の制御ワードの「読み出し」フレームを検出します。
25	デバイス 1 (R = 1, C = 0) は第 1 制御ワードのアドレスがロー = 0、コラム = 0であることを識別します。これは有効な構成書き込みアドレスのため、デバイス 1 は構成情報の送信を準備します。第 1 の制御ワードからロー・アドレスが 1 だけ減算され (ロー・アドレス = 3F) RSO に送られます。
37	デバイス 1 (R = 1, C = 0) は構成情報をアレイ出力 (デバイス 1 の RSO) から送出します。

外形寸法図 単位は millimeters



LQA32A (Rev. A)

LLP, Plastic, QUAD,
Order Number DS90CP04TLQ, DS90CP04TLQX (Tape and Reel)
NS Package Number LQA032A

このドキュメントの内容はナショナル セミコンダクター 社製品の関連情報として提供されます。ナショナル セミコンダクター 社は、この発行物の内容の正確性または完全性について、いかなる表明または保証もいたしません。また、仕様と製品説明を予告なく変更する権利を有します。このドキュメントはいかなる知的財産権に対するライセンスも、明示的、黙示的、禁反言による惹起、またはその他を問わず、付与するものではありません。

試験や品質管理は、ナショナル セミコンダクター 社が自社の製品保証を維持するために必要と考える範囲に用いられます。政府が課す要件によって指定される場合を除き、各製品のすべてのパラメータの試験を必ずしも実施するわけではありません。ナショナル セミコンダクター 社は製品適用の援助や購入者の製品設計に対する義務を負いかねます。ナショナル セミコンダクター 社の部品を使用した製品および製品適用の責任は購入者にあります。ナショナル セミコンダクター 社の製品を用いたいかなる製品の使用または供給に先立ち、購入者は、適切な設計、試験、および動作上の安全手段を講じなければなりません。

それら製品の販売に関するナショナル セミコンダクター 社との取引条件で規定される場合を除き、ナショナル セミコンダクター 社は一切の義務を負わないものとし、また、ナショナル セミコンダクター 社の製品の販売か使用、またはその両方に関連する特定目的への適合性、商品の機能性、ないしは特許、著作権、または他の知的財産権の侵害に関連した義務または保証を含むいかなる表明または黙示的保証も行いません。

生命維持装置への使用について

ナショナル セミコンダクター 社の製品は、ナショナル セミコンダクター 社の最高経営責任者 (CEO) および法務部門 (GENERAL COUNSEL) の事前の書面による承諾がない限り、生命維持装置または生命維持システム内のきわめて重要な部品に使用することは認められていません。

ここで、生命維持装置またはシステムとは (a) 体内に外科的に使用されることを意図されたもの、または (b) 生命を維持あるいは支持するものをいい、ラベルにより表示される使用方法に従って適切に使用された場合に、これの不具合が使用者に身体的障害を与えると予想されるものをいいます。重要な部品とは、生命維持にかかわる装置またはシステム内のすべての部品をいい、これの不具合が生命維持用の装置またはシステムの不具合の原因となりそれらの安全性や機能に影響を及ぼすことが予想されるものをいいます。

National Semiconductor とナショナル セミコンダクター のロゴはナショナル セミコンダクター コーポレーションの登録商標です。その他のブランドや製品名は各権利所有者の商標または登録商標です。

Copyright © 2008 National Semiconductor Corporation
 製品の最新情報については www.national.com をご覧ください。

ナショナル セミコンダクター ジャパン株式会社

本社 / 〒 135-0042 東京都江東区木場 2-17-16 TEL.(03)5639-7300

技術資料 (日本語 / 英語) はホームページより入手可能です。

www.national.com/jpn/

ご注意

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社（以下TIJといいます）及びTexas Instruments Incorporated（TIJの親会社、以下TIJないしTexas Instruments Incorporatedを総称してTIといいます）は、その製品及びサービスを任意に修正し、改善、改良、その他の変更をし、もしくは製品の製造中止またはサービスの提供を中止する権利を留保します。従いまして、お客様は、発注される前に、関連する最新の情報を取得して頂き、その情報が現在有効かつ完全なものであるかどうかをご確認下さい。全ての製品は、お客様とTIJとの間取引契約が締結されている場合は、当該契約条件に基づき、また当該取引契約が締結されていない場合は、ご注文の受諾の際に提示されるTIJの標準販売契約約款に従って販売されます。

TIは、そのハードウェア製品が、TIの標準保証条件に従い販売時の仕様に対応した性能を有していること、またはお客様とTIJとの間で合意された保証条件に従い合意された仕様に対応した性能を有していることを保証します。検査およびその他の品質管理技法は、TIが当該保証を支援するのに必要とみなす範囲で行なわれております。各デバイスの全てのパラメーターに関する固有の検査は、政府がそれ等の実行を義務づけている場合を除き、必ずしも行なわれておりません。

TIは、製品のアプリケーションに関する支援もしくはお客様の製品の設計について責任を負うことはありません。TI製部品を使用しているお客様の製品及びそのアプリケーションについての責任はお客様にあります。TI製部品を使用したお客様の製品及びアプリケーションについて想定される危険を最小のものとするため、適切な設計上および操作上の安全対策は、必ずお客様にてお取り下さい。

TIは、TIの製品もしくはサービスが使用されている組み合わせ、機械装置、もしくは方法に関連しているTIの特許権、著作権、回路配置利用権、その他のTIの知的財産権に基づいて何らかのライセンスを許諾するということは明示的にも黙示的にも保証も表明もしていません。TIが第三者の製品もしくはサービスについて情報を提供することは、TIが当該製品もしくはサービスを使用することについてライセンスを与えたり、保証もしくは承認するということを意味しません。そのような情報を使用するには第三者の特許その他の知的財産権に基づき当該第三者からライセンスを得なければならない場合もあり、またTIの特許その他の知的財産権に基づきTIからライセンスを得て頂かなければならない場合もあります。

TIのデータ・ブックもしくはデータ・シートの中にある情報を複製することは、その情報に一切の変更を加えること無く、かつその情報と結び付けられた全ての保証、条件、制限及び通知と共に複製がなされる限りにおいて許されるものとします。当該情報に変更を加えて複製することは不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような変更された情報や複製については何の義務も責任も負いません。

TIの製品もしくはサービスについてTIにより示された数値、特性、条件その他のパラメーターと異なる、あるいは、それを超えてなされた説明で当該TI製品もしくはサービスを再販売することは、当該TI製品もしくはサービスに対する全ての明示的保証、及び何らかの黙示的保証を無効にし、かつ不正で誤認を生じさせる行為です。TIは、そのような説明については何の義務も責任もありません。

TIは、TIの製品が、安全でないことが致命的となる用途ないしアプリケーション（例えば、生命維持装置のように、TI製品に不良があった場合に、その不良により相当な確率で死傷等の重篤な事故が発生するようなもの）に使用されることを認めておりません。但し、お客様とTIの双方の権限有る役員が書面でそのような使用について明確に合意した場合は除きます。たとえTIがアプリケーションに関連した情報やサポートを提供したとしても、お客様は、そのようなアプリケーションの安全面及び規制面から見た諸問題を解決するために必要とされる専門的知識及び技術を持ち、かつ、お客様の製品について、またTI製品をそのような安全でないことが致命的となる用途に使用することについて、お客様が全ての法的責任、規制を遵守する責任、及び安全に関する要求事項を満足させる責任を負っていることを認め、かつそのことに同意します。さらに、もし万一、TIの製品がそのような安全でないことが致命的となる用途に使用されたことによって損害が発生し、TIないしその代表者がその損害を賠償した場合は、お客様がTIないしその代表者にその全額の補償をするものとします。

TI製品は、軍事的用途もしくは宇宙航空アプリケーションないし軍事的環境、航空宇宙環境にて使用されるようには設計もされていませんし、使用されることを意図されていません。但し、当該TI製品が、軍需対応グレード品、若しくは「強化プラスチック」製品としてTIが特別に指定した製品である場合は除きます。TIが軍需対応グレード品として指定した製品のみが軍需品の仕様書に合致いたします。お客様は、TIが軍需対応グレード品として指定していない製品を、軍事的用途もしくは軍事的環境下で使用することは、もっぱらお客様の危険負担においてなされるということ、及び、お客様がもっぱら責任をもって、そのような使用に関して必要とされる全ての法的要求事項及び規制上の要求事項を満足させなければならないことを認め、かつ同意します。

TI製品は、自動車用アプリケーションないし自動車の環境において使用されるようには設計されていませんし、また使用されることを意図されていません。但し、TIがISO/TS 16949の要求事項を満たしていると特別に指定したTI製品は除きます。お客様は、お客様が当該TI指定品以外のTI製品を自動車用アプリケーションに使用しても、TIは当該要求事項を満たしていなかったことについて、いかなる責任も負わないことを認め、かつ同意します。

Copyright © 2011, Texas Instruments Incorporated
日本語版 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

弊社半導体製品の取り扱い・保管について

半導体製品は、取り扱い、保管・輸送環境、基板実装条件によっては、お客様での実装前後に破壊/劣化、または故障を起こすことがあります。

弊社半導体製品のお取り扱い、ご使用にあたっては下記の点を遵守して下さい。

1. 静電気

- 素手で半導体製品単体を触らないこと。どうしても触る必要がある場合は、リストストラップ等で人体からアースをとり、導電性手袋等をして取り扱うこと。
- 弊社出荷梱包単位（外装から取り出された内装及び個装）又は製品単品で取り扱いを行う場合は、接地された導電性のテーブル上で（導電性マットにアースをとったもの等）、アースをした作業者が行うこと。また、コンテナ等も、導電性のものを使うこと。
- マウンタやんだ付け設備等、半導体の実装に関わる全ての装置類は、静電気の帯電を防止する措置を施すこと。
- 前記のリストストラップ・導電性手袋・テーブル表面及び実装装置類の接地等の静電気帯電防止措置は、常に管理されその機能が確認されていること。

2. 温・湿度環境

- 温度：0～40℃、相対湿度：40～85%で保管・輸送及び取り扱いを行うこと。（但し、結露しないこと。）

- 直射日光が当たる状態で保管・輸送しないこと。
3. 防湿梱包
 - 防湿梱包品は、開封後は個別推奨保管環境及び期間に従い基板実装すること。
 4. 機械的衝撃
 - 梱包品（外装、内装、個装）及び製品単品を落下させたり、衝撃を与えないこと。
 5. 熱衝撃
 - はんだ付け時は、最低限260℃以上の高温状態に、10秒以上さらさないこと。（個別推奨条件がある時はそれに従うこと。）
 6. 汚染
 - はんだ付け性を損なう、又はアルミ配線腐食の原因となるような汚染物質（硫黄、塩素等ハロゲン）のある環境で保管・輸送しないこと。
 - はんだ付け後は十分にフラックスの洗浄を行うこと。（不純物含有率が一定以下に保証された無洗浄タイプのフラックスは除く。）

以上